

УДК 548.0 : 537.226.33

**ДИНАМИКА РЕШЕТКИ И МЕХАНИЗМЫ  
СЕГНЕТОЭЛАСТИЧЕСКИХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ  
В  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$**

*В. П. Дмитриев, Ю. И. Юзюк, Ю. И. Дурнев, Л. М. Рабкин,  
Е. С. Ларин, В. И. Патомов*

Исследованы спектры комбинационного рассеяния монокристаллического  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  в интервале температур, включающем температуры переходов из ромбической  $D_{2h}$  в несоразмерную и эквивалентные моноклинные фазы  $C_{2h}$  и  $C_4$ . Показано, что инициирующим механизмом перехода из фазы  $D_{2h}$  в несоразмерную и  $C_{2h}$  является смещение ионов цезия. В то же время для структуры этих фаз характерно наличие малоугловой ориентационной неупорядоченности тетраэдрических анионов, исчезающей при переходе в фазу  $C_4$ .

В семействе комплексных меркуроатов  $\text{Cs}_2\text{HgX}_4$  ( $X$  — ион галогена)  $\text{Br}$ -содержащие кристаллы являются наиболее изученными в структурном аспекте, расширяя список диссимметрических фаз, реализующихся в структурах типа  $\text{K}_2\text{SO}_4$  [1]. Рентгенодифракционными исследованиями установлено [2], что, кристаллизуясь в структуру типа  $\beta\text{-K}_2\text{SO}_4$  (фаза I, пр. гр.  $D_{2h}^{18}$ , число формульных единиц  $Z=4$ ),  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  при  $T_1=245$  К переходит в фазу II с несоразмерной модуляцией структуры вдоль псевдо-тексагональной оси  $a$ . Далее в точке  $T_2=232$  К происходит «lock-in» переход с  $k=0$  в моноклинную фазу III (пр. гр.  $C_{2h}^5$ ,  $Z=4$ ), а затем, при  $T_3=167$  К, эквивалентный переход в фазу IV (пр. гр.  $C_4^1$ ,  $Z=4$ ). Еще один, уже антиферродисторсионный переход с удвоением объема ячееки, но без изменения точечной симметрии, зафиксирован при  $T_4=-85$  К.

Наличие достоверных данных [2] о структуре диссимметрических фаз  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$ , дополненных сведениями об аномалиях в динамике его кристаллической решетки, создает предпосылки для аргументированного обсуждения механизмов и выявления параметров наблюдаемых в нем фазовых переходов. Задача же эта имеет более широкое значение, чем получение ответа для конкретного кристалла, так как картина фазовых переходов и микроскопических механизмов их реализации в обширном семействе кристаллов со структурой типа  $\text{K}_2\text{SO}_4$  пока еще далека от полной ясности.

Целью данной работы явилось исследование методами спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) температурного поведения колебательных спектров  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$ , проведение симметрийного анализа иска-  
жений структуры кристалла и различных механизмов нестабильности решетки при переходах, сопоставление полученных данных и конкретизация на этой основе механизмов понижения симметрии.

**1. Температурное поведение колебательных спектров**

Спектры КР монокристаллических образцов  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$ , вырезанных по кристаллографическим осям ( $a=10.248$ ,  $b=7.927$ ,  $c=13.901$  Å [2]),

возбуждались криптоновым лазером ИК-120 ( $\lambda=647.1$  нм) и регистрировались спектрометром ДФС-24.

Дополнительная математическая обработка спектров на ЭВМ проводилась с помощью модели аддитивных осцилляторов с затуханием пубебаевского релаксатора. Экспериментальные спектры аппроксимировались функцией вида

$$J(\omega, T) = (n(\omega, T) + 1) \left[ \sum_{i=1}^N \frac{A_i \Gamma_i \Omega_i^2 \omega}{(\Omega_i^2 - \omega^2)^2 + \Gamma_i^2 \omega^2} + \frac{A_K \tau_K \omega}{1 + \tau_K^2 \omega^2} \right], \quad (1)$$

где  $n(\omega, T)$  — фактор Бозе-Эйнштейна;  $\Omega_i$  — собственная частота осциллятора;  $\Gamma_i$  — константа затухания;  $A_i$  ( $A_K$ ) — константа, пропорциональная силе  $i$ -го осциллятора (релаксатора);  $\tau_K$  — время релаксации. Подгонка осуществлялась методом наименьших квадратов до совпадения (в пределах погрешности эксперимента) экспериментального спектра с суммарным спектром отдельных

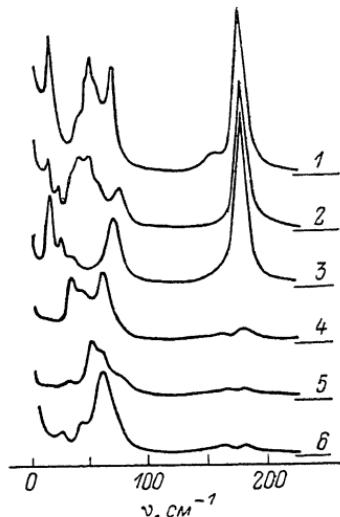


Рис. 1. Спектры КР  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  при 290 К.

Ориентации: 1 —  $Y(ZZ)X$ , 2 —  $Z(YY)X$ , 3 —  $Y(XX)Z$ , 4 —  $Y(XY)Z$ , 5 —  $Z(XZ)Y$ , 6 —  $Y(ZY)X$ .

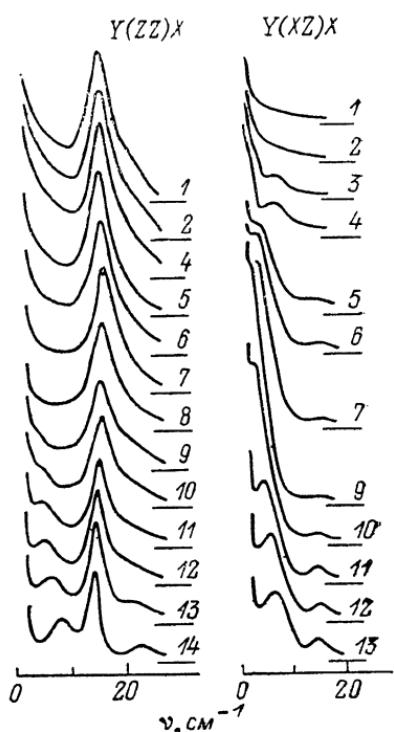


Рис. 2. Температурная эволюция низкочастотных спектров КР  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$ .

Т, К: 1 — 290, 2 — 245, 3 — 240, 4 — 232, 5 — 230, 6 — 220, 7 — 200, 8 — 170, 9 — 160, 10 — 155, 11 — 140, 12 — 130, 13 — 120, 14 — 100.

контуров для частот, превышающих вертикальный склон рэлеевской линии, где рэлеевское и мандельштам-брюллюзновское рассеяние можно уже не учитывать.

Спектр внутренних колебаний тетраэдрических анионов  $\text{HgBr}_4^{2-}$  (рис. 1) имеет структуру, сходную с аналогичным спектром  $\text{HgCl}_4^{2-}$  [3] и указывающую на наличие существенных искажений этих молекулярных группировок. Однако температурное их поведение не дало какой-либо специфической информации, полезной при обсуждении механизмов фазовых переходов. Именно поэтому в дальнейшем все внимание будет сосредоточено на низкочастотной области спектра, в которую попадают внешние решеточные колебания кристалла.

Поляризационные характеристики спектров КР  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  при комнатной температуре полностью отражают ромбическую симметрию фазы I. Характерной особенностью является наличие в спектре КР релаксационного крыла рэлеевской линии (для  $3 < \nu < 30 \text{ cm}^{-1}$ ), наиболее ярко выраженного в ориентации  $Y(ZZ)X$  и отсутствующего в другой диагональной ориентации  $Y(XX)Z$  (рис. 1). Подгонка экспериментальных

спектров в ZZ-ориентации выражением вида (1) позволила определить характеристическое время этих релаксационных возбуждений  $\tau_R \sim 5 \cdot 10^{-13}$  с. Спектры КР в XX-, XY- и XZ-ориентациях в низкочастотной области вполне удовлетворительно аппроксимируются набором только осцилляторов, что свидетельствует о поляризованности релаксационных возбуждений.

Понижение температуры вплоть до  $T_1$  слабо сказывается на спектрах, однако переход в несоразмерную фазу III приводит к некоторому увеличению числа наблюдаемых линий в низкочастотной области спектра (рис. 2, 3). Логично предположить, что причиной последнего является многократное «складывание» зоны Бриллюэна (ЗБ) вследствие понижения трансляционной симметрии кристалла, в результате которого часть внутренних точек ЗБ оказывается в центре, а соответствующие колеба-

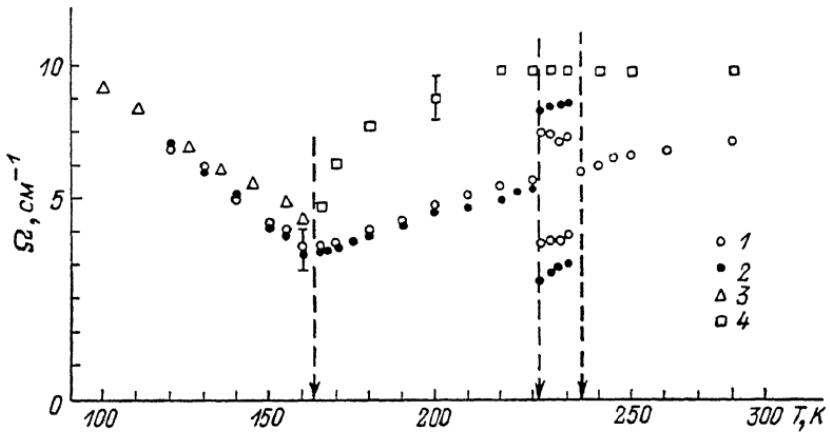


Рис. 3. Температурные зависимости частот (1–3) и обратного времени релаксации (4) в низкочастотных спектрах КР.

Ориентации: 1 — Y (XY) X; 2 — Y (XZ) X; 3, 4 — Y (ZZ) X.

тельные возбуждения становятся активными в оптических процессах, причем именно низкоэнергетические состояния, имеющие наибольшую дисперсию, проявляют это в наибольшей степени. Последующий переход в фазу III уменьшает число линий спектра КР, что отражает восстановление трансляционной симметрии кристалла при  $T_2$ . Соответственно понижению точечной симметрии кристалла изменяется и вид тензора КР колебаний  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$ , приобретая вид, характерный для кристаллов моноклинной сингонии с осью второго порядка, параллельной оси X.

В фазе III происходят существенные температурные изменения спектров КР. Прежде всего в ориентации XZ ниже  $T_2$  возгорается линия моды  $5 \text{ cm}^{-1}$ , которая выше  $T_1$  наблюдалась в XY-ориентации. Это обусловлено изменением правил отбора, поскольку ниже  $T_2$  в моноклинной фазе обе ориентации XZ и XY соответствуют модам одной симметрии —  $B_g$ . В фазе III наблюдается линейное «размягчение» этого низкочастотного  $B_g$ -колебания, и в точке  $T_3$  производная  $\partial\omega/\partial T$  этого колебания, оставаясь константой, меняет знак и вдвое увеличивает абсолютную величину, т. е. его частота после перехода в фазу IV линейно растет при дальнейшем понижении температуры (рис. 2, 3). Ниже  $T_3$  мода 4  $\text{cm}^{-1}$  с аналогичным температурным поведением появляется и в диагональной ориентации Y(ZZ)X (рис. 2, 3), что также обусловлено изменением правил отбора, так как дальнейшему понижению симметрии  $C_{2h} \rightarrow C_i$  соответствует корреляция представлений  $B_g \rightarrow A_g$ . Полная картина температурных зависимостей частот внешних решеточных колебаний  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  приведена на рис. 4. Кроме того, в фазе III с приближением к  $T_3$  происходит существенное уменьшение частоты  $\omega_R = 1/\tau_R$  релаксационного колебания (рис. 3) и его интенсивности  $A_R$ , что свидетельствует о замедлении соответствующего движения (о природе которого речь пойдет ниже).

в этой фазе и полном его прекращении в фазе IV. Спектры ZZ-ориентации в фазе IV, как и в других ориентациях, вполне удовлетворительно аппроксимируются набором только осцилляторов.

## 2. Симметрийный аспект переходов в $Cs_2HgBr_4$

В кристаллах с общей формулой  $A_2BX_4$ , ромбическая фаза которых имеет структуру типа  $\beta\text{-K}_2SO_4$ , как известно, не только возможна, но и наблюдалась гексагональная фаза симметрии  $D_{6h}^4$  ( $Z=2$ ) [4]. Для общности рассмотрения будем анализировать экспериментальные данные по  $Cs_2HgBr_4$  исходя из предположения о реальности (хотя бы и при специ-

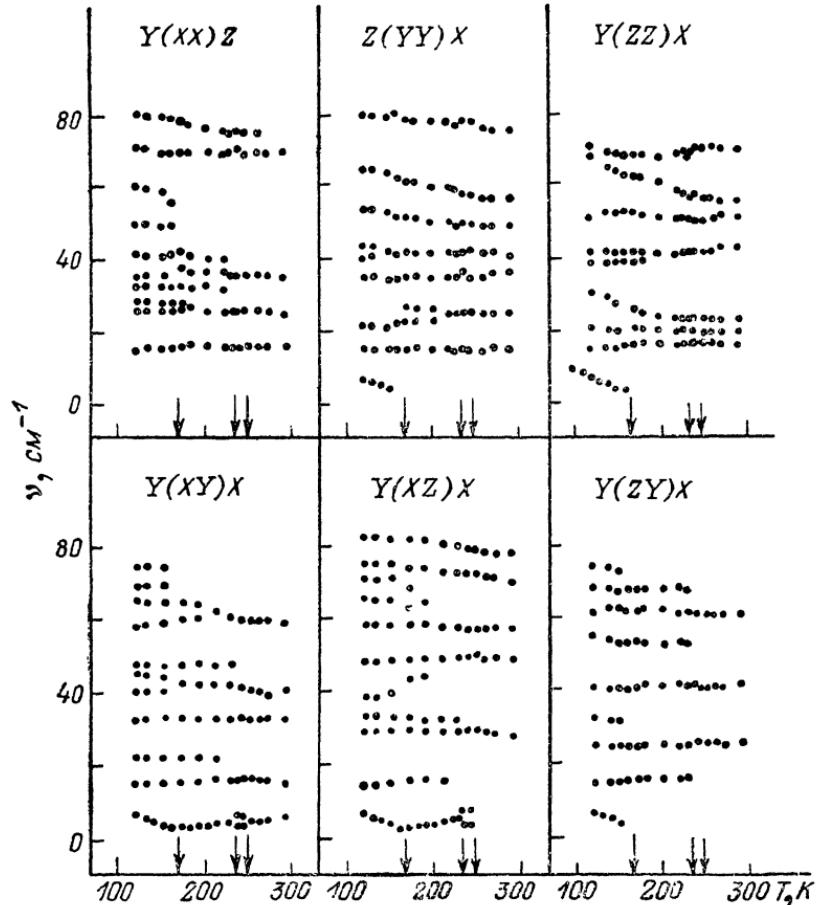


Рис. 4. Температурные зависимости частот решеточных колебаний в  $Cs_2HgBr_4$ .  
Стрелками указаны температуры фазовых переходов.

физических условиях) его перехода в гексагональную прафазу. Как будет видно, это позволит дополнительно дифференцировать механизмы искажения решетки кристалла.

Известно, что параметр перехода (ПП) из прафазы в структуру типа  $\beta\text{-K}_2SO_4$  преобразуется по трехмерному неприводимому представлению  ${}^1M_4$  группы  $D_{6h}^4$  и в ромбической фазе (т. е. фазе I  $Cs_2HgBr_4$ ) отлична от нуля только одна из компонент ПП [6]. Для описания переходов в фазы иной точечной, но той же трансляционной симметрии (III и IV) необходимо привлечение еще как минимум одного ПП, причем он должен принадле-

<sup>1</sup> Для неприводимых представлений здесь используются обозначения типа  $M_i^{(\alpha)}$ , где  $M$  — точка ЗБ,  $i$  — номер представления в соответствии с [5],  $\alpha$  — номер базисной функции представления.

жать точкам  $\Gamma$  или  $M$  гексагональной ЗБ, характеризуемым векторами  $k_{16}=0$  и  $k_{12}=b_1/2$  соответственно. Прямой проверкой легко установить, что фаза симметрии  $C_{2h}^5$  с необходимым вложением решеток может возникнуть, если ПП преобразуется по одному из трех ПП: трехмерному  $M_2$ , одномерному  $\Gamma_3=A_{2g}$  или двумерному  $\Gamma_{11}=E_{2g}$ . Базисные функции НП  $M_2$  описывают смещение ионов  $\text{Cs}^\ddagger$ , в прафазе занимающих позицию 2 (a), и повороты анионов  $\text{HgBr}_4^{2-}$ ; представлению  $\Gamma_3$  соответствуют повороты анионов вокруг оси шестого порядка прафазы или а фазы I  $\text{CsHgBr}_4$ , а  $\Gamma_{11}$  — их смещения в плоскости  $YZ$  структуры фазы I и аналогичные смещения ионов цезия, в прафазе размещавшихся в позиции 2(d) —  $\text{Cs}^\ddagger$  [6, 7].

Однако из анализа структурных данных [2] следует, что искажения симметрии  $\Gamma_{11}$  в фазе III не реализуются, а вот два первых типа легко идентифицируются. Если не учитывать псевдогексагональный характер фазы I и классифицировать механизмы на основе только ромбической симметрии, то связать их, т. е. выявить собственно ПП и отделить «квазисобственные» искажения, было бы практически невозможно, так как все они преобразуются по одному и тому же НП  $B_{3g}$  группы  $D_{2d}$  фазы I. В неравновесном потенциале прафазы присутствует тройное произведение  $(M_2^{(3)} \cdot M_4^{(3)} \cdot \Gamma_3)$ , и при ненулевом  $M_4^{(3)}$ , т. е. в фазе I, возникновение одной любой из пары величин  $M_2^{(3)}$  или  $\Gamma_3$  неизбежно приводит к появлению (индуцированию) второй.

Учет гексагональной симметрии прафазы позволяет среди функций, образующих базисы одномерного НП ромбической фазы  $B_{3g}$ , выделить «сконденсировавшиеся» при гипотетическом переходе компонента многомерных представлений, что важно в данном случае для понимания закономерности образования несоразмерной фазы II. Если второй ПП преобразуется по  $\Gamma_3$ , удовлетворяющему условию Лифшица, то образование промежуточной несоразмерной фазы между эквивалентными ромбической и моноклинной происходит не должно. Подобная ситуация — однокомпонентный ПП и отсутствие несоразмерной фазы — реализуется в сульфате аммония [8]. Иное дело многокомпонентный ПП, когда даже при выполнении условия Лифшица существуют симметрии по обусловленные причины появления таких фаз [9, 10]. Так, в случае  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  неравновесная энергия в гексагональной прафазе будет содержать неоднородный член типа  $M_4^{(3)} \cdot M_2^{(3)} \cdot (\partial M_2^{(1)} / \partial Z) - \dots$  с  $M_2$ , хотя и удовлетворяющим условию Лифшица, но который в фазе I тем не менее трансформируется в инвариант Лифшица и описывает возникновение фазы II с несоразмерной модуляцией кристаллической решетки в псевдогексагональном направлении а [10].

Механизмы перехода в фазу IV из-за недостатка структурных данных не поддаются анализу, остаются лишь варианты симметрии ПП:  $M_6$ ,  $M_8$ ,  $\Gamma_5$  или  $\Gamma_9$ .

### 3. Динамический аспект переходов в $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$

Многовариантность механизмов возникновения статической картины искажений структуры может быть снята учетом реального поведения динамических параметров кристаллической решетки. Для изоструктурных кристаллов  $\text{K}_2\text{SO}_4$  ранее экспериментально было показано наличие в ромбической фазе динамической ориентационной неупорядоченности тетраэдрических анионов [11], причем методы колебательной спектроскопии оказались более надежным индикатором, чем рентгеновская дифракция. Аналогичная ситуация, по-видимому, имеет место и в фазе I  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$ , подтверждением чего является наличие квазиупругой компоненты в его спектре, которая отвечает малоугловым ориентационным перескокам группы  $\text{HgBr}_4^{2-}$ . Такие перескоки имеют релаксационный характер, а время релаксаций, как отмечалось выше, составляет  $5 \cdot 10^{-13}$  с, т. е. оказывается вполне приемлемым для переориентации тетраэдрических групп на малые углы [12]. Отсутствие заметных аномалий в поведении этого

релаксатора при  $T_1$  и  $T_2$  (рис. 3) указывает уже на иной характер нестабильности фазы I  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$ , а наличие единственного альтернативного механизма (см. п. 2) приводит к выводу, что характер перехода в фазы II и III есть не что иное, как смещение ионов  $\text{Cs}^+$ . Такому механизму нестабильности должна была бы сопутствовать «мягкая» мода, которую, однако, в спектре фазы I  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  наблюдать не удалось. Причиной этого может быть, во-первых, малая интенсивность из-за происхождения с границы ЗБ, а, во-вторых, наличие аномально широкого крыла рэлеевской линии, ухудшающее разрешение низкочастотного спектра. Отметим, что в кристаллах  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  в аналогичной ситуации наблюдение «мягкой» моды становилось возможным только после «lock-in» перехода [3].

Интересно описанное в п. 1 поведение наиболее низкочастотного колебания, температурная зависимость частоты которого хорошо воспроизведит классическое поведение квадрата ПП, включая выполнение «закона двойки». Единственным отличием является ее непулевое значение в точке перехода второго рода  $T_3$ . Такое поведение, по-видимому, есть результат билинейного связывания колебательной степени свободы с квадратом истинного ПП. А инициирующим механизмом этого перехода, с которым взаимодействует указанная мода, является ориентационное упорядочение комплексов  $\text{HgBr}_4^{2-}$ , на что указывает критическое сужение квазиупругого пика, соответствующее замедлению перескоков анионов (рис. 3). Такая конкретизация физической реализации ПП приводит, естественно, и к ограничению вариантов его симметрии. Выпадают из рассмотрения ПП, описывающие только смещения фрагментов структуры, и остаются  $M_6$  и  $\Gamma_9 = E_{2g}$ , учитывающие результирующий разворот групп  $\text{HgBr}_4^{2-}$ .

Особенности и температурное поведение колебательных спектров  $\text{Cs}_2\text{HgBr}_4$  приводят к заключению, что инициирующим механизмом перехода из фазы I в II и III является смещение ионов  $\text{Cs}^+$ . В то же время для структуры этих фаз характерно наличие малоугловой ориентационной неупорядоченности тетраэдрических анионов  $\text{HgBr}_4^{2-}$ , исчезающей при переходе в фазу IV.

#### Список литературы

- [1] Plesko S., Kind R., Arendt H. // Phys. St. Sol. (a). 1980. V. 61. N 1. P. 87—95.
- [2] Altermatt D., Arendt H., Gramlich V., Niggli A., Petter W. // Acta Cryst. 1984. V. B40. N 4. P. 347—350.
- [3] Дмитриев В. П., Юзюк Ю. И., Трегубченко А. В., Ларин Е. С., Кирпленко В. В., Пахомов В. И. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 4. С. 1214—1216.
- [4] Shiozaki S., Sawada A., Ishibashi Y., Takagi Y. // J. Phys. Soc. Jap. 1977. V. 43. N 3. P. 1314—1321.
- [5] Petzelt J., Kozlov G. V., Volkov A. A., Ishibashi Y. // Z. Physik. 1979. V. B33. N 2. P. 368—379.
- [6] Sawada A., Takagi Y., Makita Y. // J. Phys. Soc. Jap. 1976. V. 41. N 1. P. 174—181.
- [7] Торгашев В. И., Юзюк Ю. И., Рабкин Л. М., Федосюк Р. М. // Кристаллография. 1988. Т. 33. № 1. С. 143—150.
- [8] Sawada A., Takagi Y., Ishibashi Y. // J. Phys. Soc. Jap. 1973. V. 34. N 3. P. 748—754.
- [9] Крайzman И. Л., Сахненко В. П. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 40. № 5. С. 173—175.
- [10] Крайzman И. Л., Сахненко В. П. // Кристаллография. 1986. Т. 31. № 1. С. 167—169.
- [11] Massa N., Ullman F., Hardy J. R. // Phys. Rev. B. 1983. V. 27. N 3. P. 1523—1540.
- [12] Unruh H.-G., Eller W., Kirf G. // Phys. St. Sol. (a). 1979. V. 55. N 1. P. 173—180.

Ростовский-на-Дону  
государственный университет  
НИИФ  
Ростов-на-Дону

Поступило в Редакцию  
13 июня 1988 г.  
В окончательной редакции  
21 ноября 1988 г.